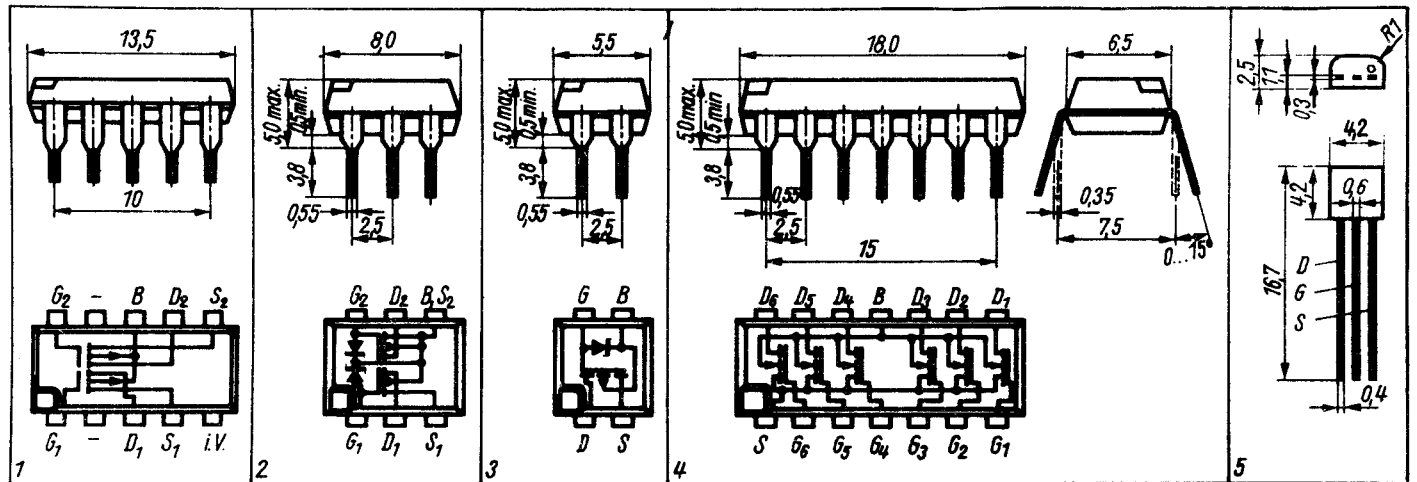


Halbleiterbauelemente aus der DDR-Produktion 1980

Typ	P _{tot} mW	U _{DS} U _{DB} V	U _{GS} U _{GB} V	U _{DG} V	U _{SB} V	I _D mA	Y ₂₁ mS	Bei U _{DS} V	-U _T V	Bei I _D μA	R _e T	I _D mA	Verwendung	Anschluß- schema
Si-MOSFET (n-Kanal-Verarmungstyp)														
SM 103	150	20	-15/+5	32	-	15	> 1,3	8	< 12	10	> 1,0	3 ...12	allgemein	5
SM 104	150	20	-15/+5	30	-	15	> 1,0	8	< 8	10	> 1,0	1,5... 6,5	allgemein	5
Si-MOSFET (p-Kanal-Anreicherungstyp)														
SMY 50	225	-31/+0,3	-31/+0,3	±31	-15/+0,3	-25	> 2	-10	> -3	-10	-	> -10	digit. Schaltg.	3
SMY 51 ¹	240	-31/+0,3	-31/+0,3	±31	0	-20	> 2	-10	> -3	-10	-	> -12	digit. Schaltg.	2
SMY 52	300	-31/+0,3	-31/+0,3	±31	-15/+0,3	-60	> 12,5	-10	> -3	-10	-	> -50	digit. Schaltg.	3
SMY 60 ²	240	-25/+0,3	-25/+0,3	±25	-15/+0,3	-20	-	-	> -2,8	-10	-	-	analoge Schaltg.	1
U 105 D ³	400	-31/+0,3	-31/+0,3	±31	0	-25	-	-2	> -3	-10	-	> -3	allgemein	4

1 Doppeltransistor; 2 Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden; 3 6fach-Transistor.



Typ	U _R V	U _{RRM} [U _{RWM}] V	U _{RSM} V	I _F mA	I _{FRM} [I _{FWM}] mA	I _{FSM} mA	U _F V	Bei I _F mA	I _R μA	Bei U _R V	[C _{tot}] [pF] °C	P _{tot} mW	Verwendung	Anschluß- schema
Germanium-Universaldioden														
▶ GA 100	20	26	30	20	45	100	< 1	5	< 100	10	80	-	Demodulation	1
▶ GA 101	40	50	55	15	45	100	< 1	3	< 40	10	80	-	universell	1
▶ GA 102	60	70	80	12	45	100	< 1	3	< 40	10	80	-	universell	1
▶ GA 103	80	90	100	10	45	100	< 1	3	< 15	10	80	-	universell	1
▶ GA 104	110	115	120	10	45	100	< 1	3	< 15	10	80	-	universell	1
▶ GA 105	20	26	30	20	45	100	< 1	3	< 100	10	80	-	Demodulation	1
▶ GA 108	80	90	100	20	45	100	< 1	5	< 6	10	80	-	universell	1
▶ GAZ 17	25	-	-	20	120	-	< 1	5	< 30	10	85	100	Rechenanlagen	1
Germanium-Diodenpaare- und -Quartette														
▶ 2 GA 109	40	50	55	15	45	100	1	> 5	40	10	80	-	Ratiodetektor	1
▶ 2 GA 113	25	35	-	-	30	50	1	> 6	40	10	100	-	Ratiodetektor	1
▶ 4 GA 114	25	35	-	-	30	50	1	6/15	40	10	75	-	Modulator	1,2
Germanium-Schaltdioden														
▶ GAY 60	20	25	30	75	225	500	< 1	75	< 1000	20	[< 1,5]	80	Rechen- u. Datenanlagen	1
▶ GAY 61	20	25	30	100	300	500	< 0,7	75	< 1000	20	[< 1,5]	80		1
▶ GAY 62	20	25	30	100	300	500	< 0,5	75	< 50	10	[< 1,5]	80		1
▶ GAY 63	40	50	60	100	300	500	< 0,8	75	< 50	10	[< 1,5]	80		1
▶ GAY 64	80	90	100	75	225	500	< 1	75	< 50	10	[< 1,5]	80		1
Silizium-Schaltdioden														
SAY 12	50	75	-	300	600	2000	< 1	200	< 0,1	50	[< 4]	430	orange grün Schalter rot gelb schw.	5,6
SAY 16	30	35	-	300	600	2000	< 1	200	< 0,1	30	[< 4]	430		5,6
SAY 17	50	60	-	175	350	2000	< 1	100	< 0,1	50	[< 3]	300		5,6
SAY 18	25	35	-	115	225	2000	< 1	30	< 0,07	25	[< 4]	300		5,6
SAY 20	15	20	-	75	150	2000	< 1	10	< 0,05	15	[< 4]	300		5,6
SAY 30	25	30	-	30	60	150	< 0,81	3	< 0,04	25	[< 8]	150	NF, HF, Logik mittelschnell NF, HF, Logik schnell	4
SAY 32	25	30	-	50	100	250	< 1	15	< 0,04	25	[< 8]	150		4
SAY 40	15	20	-	20	40	100	< 0,84	3	< 0,06	15	[< 8]	150		4
SAY 42	15	20	-	30	60	150	< 1	10	< 0,06	15	[< 8]	150		4
SAY 43	50	75	-	300	600	2000	< 1	200	< 0,1	50	[< 4]	430		6
SA 403	25	30	-	30	60	150	< 0,81	3	< 0,04	25	[< 8]	100	NF-, HF- u.	rt 7
SA 418	80	-	-	100	-	-	< 1,2	100	< 0,5	80	[< 8]	100	Digitaltechnik	gr 7

Typ	P _{tot} mW	U _R V	U _{RWM} V	I _F mA	I _{FWM} mA	U _F V	Bei I _F mA	I _R nA	Bei U _R V	C _{tot} pF	t _{tr} ns	l mm	Verwendung	An- schluß- schema
Silizium-Mehrfachdioden														
SAL 41	150	15	20	20	40	<1,7	0,1	<60	15	<6	<10	4,2	schneller Schalter	8
SAL 43	200	15	20	20	40	<1,7	0,1	<60	15	<6	<10	10,1		9
SAL 45	300	15	20	20	40	<1,7	0,1	<60	15	<6	<10	15,1		9
SAM 42	150	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	9,0	HF-, NF-, Digital- tech. schneller Schalter	9
SAM 43	200	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	11,5		9
SAM 44	250	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	14,0		9
SAM 45	300	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	16,5	HF-, NF-, Digi- taltech. schneller Schalter	9
SAM 62	150	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	9,0		9
SAM 63	200	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	11,5		9
SAM 64	250	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	14,0		9
SAM 65	300	15	20	20	40	<0,84	3	<60	15	<8	<10	16,5		9

Typ	I _Z mA	U _Z V	r _Z I _Z = 5 mA Ω	U _R I _R = 1 μA V	An- schluß- schema
-----	----------------------	---------------------	--	--	--------------------------

Silizium-Z-Dioden 250 mW

SZX 21/1	200	0,73... 0,83	< 8	-	5
SZX 21/5,1	43	4,8 ... 5,4	<60	-	5
SZX 21/5,6	40	5,2 ... 6,0	<40	> 1	5
SZX 21/6,2	37	5,8 ... 6,6	<10	> 1	5
SZX 21/6,8	34	6,4 ... 7,2	< 8	> 2	5
SZX 21/7,5	31	7,0 ... 7,9	< 7	> 2	5
SZX 21/8,2	27	7,7 ... 8,7	< 7	> 3,5	5
SZX 21/9,1	25	8,5 ... 9,6	<10	> 3,5	5
SZX 21/10	23	9,4 ...10,6	<15	> 5	5
SZX 21/11	21	10,4 ...11,6	<20	> 5	5
SZX 21/12	19	11,4 ...12,8	<20	> 7	5
SZX 21/13	17	12,6 ...14,0	<25	> 7	5
SZX 21/15	16	13,8 ...15,5	<30	>10	5
SZX 21/16	14	15,3 ...17,0	<40	>10	5
SZX 21/18	12,5	16,8 ...19,0	<55	>10	5
SZX 21/20	11,5	18,8 ...21,0	<55	>10	5
SZX 21/22	10,5	20,8 ...23,0	<55	>12	5
SZX 21/24	9	22,8 ...25,6	<80	>12	5

Von der Redaktion wurde das Datenmaterial für die Belange der Amateurpraxis zusammengestellt. Zur Information der Industrie gibt es ausführlichere Unterlagen der Herstellerwerke.

► = Dieser Bauelementetyp wird nicht mehr gefertigt.

Typ	U _R V	U _{RRM} V	I _{FN} A	I _R μA	An- schluß- schema
-----	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Germanium-Gleichrichterdioden

► GY 099	12	12	0,1	> 100	10
► GY 100	24	24	0,1	< 100	10
► GY 101	40	40	0,1	< 100	10
► GY 102	75	75	0,1	< 100	10
► GY 103	100	100	0,1	< 100	10
► GY 104	150	150	0,1	< 50	10
► GY 105	200	200	0,1	< 50	10

